PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11168324 A

(43) Date of publication of application: 22 . 06 . 99

(51) Int. CI H03B 5/12

(21) Application number: 09333169

(22) Date of filing: 03 . 12 . 97 (72) Inventor:

(71) Applicant: MURATA MFG CO LTD

> HAYAFUJI HISAO YAMAMOTO HIROYUKI

(54) VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a voltage controlled oscillator capable of lowering a high order higher harmonic level and obtaining desired output power.

SOLUTION: In this voltage controlled oscillator 1a, a resonance circuit 2 switches two different resonance frequencies and resonates. By turning ON/ OFF the diode D1 of an impedance adjustment circuit 6a corresponding to the switched respective frequencies, the inductors L2 and L3 of a matching circuit 5 are selectively used and inductance is changed. Thus, synthetic impedance with a capacitor C6 for matching is changed and matched to the respective two frequencies.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

		 •	
	·		
,			

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-168324

(43)公開日 平成11年(1999)6月22日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号

FΙ

H 0 3 B 5/12

H03B 5/12

Α

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

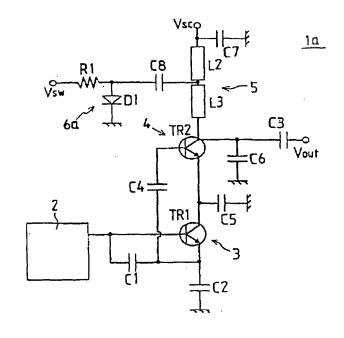
			
(21)出願番号	特願平9-333169	(71) 出願人	000006231
			株式会社村田製作所
(22)出願日	平成9年(1997)12月3日		京都府長岡京市天神二丁目26番10号
		(72)発明者	早藤 久夫
			京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
			会社村田製作所内
		(72)発明者	山本 浩之
			京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
			会社村田製作所内

(54) 【発明の名称】 電圧制御発振器

(57) 【要約】

【課題】 高次高調波レベルを下げ、所望の出力電力を得ることが可能な電圧制御発振器を提供する。

【解決手段】 電圧制御発振器 1 a において、共振回路 2 は異なる 2 つの共振周波数を切り換えて共振する。切り換えられたそれぞれの周波数に応じて、インピーダンス調整回路 6 a のダイオードD 1をオンオフさせることにより、整合回路 5 のインダクタ L 2、 L 3 を選択的に使用し、インダクタンスを変化させる。これにより、整合用コンデンサ C 6 との合成インピーダンスが変化し、2 つの周波数のそれぞれに整合させる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに異なる2つの周波数のいずれかを 選択し、該選択された周波数で共振された信号を出力す る共振回路と、

第1のトランジスタを備えてなり、前記共振回路の出力 信号を増幅し、発振する発振回路と、

第2のトランジスタを備えてなり、前記発振回路の出力 信号を増幅するバッファ回路と、

インダクタおよび整合用コンデンサを備えてなり、前記 バッファ回路の出力信号を整合する整合回路と、

スイッチング素子を備えてなるインピーダンス調整回路 を有する電圧制御発振器であって、

前記インピーダンス調整回路を構成する前記スイッチン グ素子を、印加される電圧に応じてオンオフさせること により、前記整合回路における合成インピーダンスを変 化させ、前記共振回路で選択された周波数に整合させた ことを特徴とする電圧制御発振器。

【請求項2】 前記整合回路を構成する前記インダクタ が互いに直列に接続された第1のインダクタおよび第2 のイングククからなり、

第1のインダクタおよび第2のインダクタの接続点が、 前記インピーダンス調整回路を構成する前記スイッチン グ素子に接続されたことを特徴とする請求項1に記載の 電圧制御発振器。

【請求項3】 前記インピーダンス調整回路を構成する 前記スイッチング素子が、前記整合回路を構成する整合 用コンデンサに、直列または並列に接続されたことを特 徴とする請求項1に記載の電圧制御発振器。

【請求項4】 前記インピーダンス調整回路を構成する 前記スイッチング素子が、前記整合回路を構成する前記 インダクタに並列に接続されたことを特徴とする請求項 1に記載の電圧制御発振器。

【請求項5】 前記スイッチング素子が、ダイオード、 トランジスタ、もしくはバリキャップダイオードのいず れかからなることを特徴とする請求項1乃至4のいずれ かに記載の電圧制御発振器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、各種高周波装置に 搭載される電圧制御発振器に関し、特に、発振周波数と して、互いに異なる2つの周波数を切り換えて動作する 電圧制御発振器に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の電圧制御発振器の構成を、図4を 用いて説明する。

【0003】図4において、1は電圧制御発振器であ り、共振回路2、発振回路3、バッファ回路4および整 合回路5を備えてなる。

【0004】このうち、共振回路2は、互いに異なる2

で共振された信号を出力する回路である。この共振回路 2の具体的な回路構成は、特に図示しないが、例えば、 互いに異なる共振周波数で共振する2つの共振装置から なり、どちらか一方の共振装置を選択して駆動し、2つ の周波数信号を切り換えて出力するものがある。また、 その他に、インダクタおよびコンデンサを備えてなり、 これらの素子に発生するインダクタンスまたは容量を調 整することにより、合成インピーダンスを調整し、互い に異なる2つの周波数信号を切り換えて出力するものが ある。

【0005】また、発振回路3は、第1のトランジスタ TR1と、第1のトランジスタTR1のベースーエミッ タ端子間に接続されるコンデンサC1とを備える。第1 のトランジスタTR1のエミッタ端子はコンデンサC2 を介して接地される。

【0006】また、バッファ回路4は、第2のトランジ スクTR2を備えるものであり、第2のトランジスタT R2のコレクタ端子は、コンデンサC3を介して、出力 端子Voutに接続される。また、第1のトランジスタ TR1のエミック端子と、第2のトランジスタTR2の ベース端子とは、カップリングコンデンサC4を介して 接続される。また、第1のトランジスタTR1のコレク タ端子と第2のトランジスタTR2のエミッタ端子との 接続点は、コンデンサC5を介して接地される。このコ ンデンサC5は、発振回路3とバッファ回路4とで共用 されるものである。

【0007】また、整合回路5は、インダクタレ1およ び整合用コンデンサC6を備えてなるものであり、イン ダクタL1の一端は第2のトランジスタTR2のコレク タ端子に接続され、インダクタ L 1 の他端は電源電圧入 力端子Vscに接続される。また、第2のトランジスタ TR2のコレクタ端子と出力端子Voutとの接続点 は、整合用コンデンサC6を介して接地される。また、 インダクタL1の他端と電源電圧入力端子Vscとの接 続点は、整合用コンデンサC7を介して接地される。

【0008】このように構成される電圧制御発振器1に おいては、使用する発振周波数を、例えば、800MH z帯の周波数faから1.6GHz帯の周波数fbへ切 り換えることができる。すなわち、共振回路2の出力信 号は、第1のトランジスタTR1のベース端子に入力さ れ、コンデンサC1で増幅されて発振される。この発振 信号は、カップリングコンデンサC4を介して第2のト ランジスタTR2のベース端子に入力され、第2のトラ ンジスタTR2で増幅された後、第2のトランジスタT R2のコレクタ端子から整合回路5に入力され、整合回 路5で整合され、出力端子Voutから、電圧制御発振 器1の外部へ出力される。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】ところが、従来の電圧 つの周波数のいずれかを選択し、その選択された周波数 50 制御発振器1においては、次のような問題点があった。

すなわち、電圧制御発振器1の発振周波数として、80 OMH 2 帯の周波数 faと、1.6GH 2 帯の周波数 f bを切り換えて使用する場合、fbが、faの高次高調 波である2 f a に近似する値であると、 f b の出力電力 を得るためには、2 f a の高次高調波レベルを下げるこ とが困難となり、所望の出力電力を得ることが困難であ

【0010】そこで、本発明においては、高次高調波レ ベルを下げ、所望の出力電力を得ることが可能な電圧制 御発振器を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた め、本発明にかかる電圧制御発振器においては、互いに 異なる2つの周波数のいずれかを選択し、該選択された 周波数で共振された信号を出力する共振回路と、第1の トランジスタを備えてなり、前記共振回路の出力信号を 増幅し、発振する発振回路と、第2のトランジスタを備 えてなり、前記発振回路の出力信号を増幅するバッファ 回路と、インダクタおよび整合用コンデンサを備えてな り、前記バッファ回路の出力信号を整合する整合回路 と、スイッチング素子を備えてなるインピーダンス調整 回路を有する電圧制御発振器であって、前記インピーダ ンス調整回路を構成する前記スイッチング素子を、印加 される電圧に応じてオンオフさせることにより、前記整 合回路における合成インピーダンスを変化させ、前記共 振回路で選択された周波数に整合させたことを特徴とす

【0012】また、前記整合回路を構成する前記インダ クタが互いに直列に接続された第1のインダクタおよび 第2のインダクタからなり、第1のインダクタおよび第 30 2のインダクタの接続点が、前記インピーダンス調整回 路を構成する前記スイッチング素子に接続されたことを 特徴とする。

【0013】また、前記インピーダンス調整回路を構成 す前記スイッチング素子が、前記整合回路を構成する整 合用コンデンサに、直列または並列に接続されたことを 特徴とする。

【0014】また、前記インピーダンス調整回路を構成 する前記スイッチング素子が、前記整合回路を構成する 前記インダクタに並列に接続されたことを特徴とする。 【0015】また、前記スイッチング素子が、ダイオー ド、トランジスタ、もしくはバリキャップダイオードの いずれかからなることを特徴とする。

【0016】本発明にかかる電圧制御発振器において は、共振回路で選択された周波数に応じて、インピーダ ンス調整回路を構成するスイッチング素子がオンオフさ れる。これにより、整合回路におけるインダクタンスま たは容量が変化し、その結果、合成インピーダンスが変 化し、2つの周波数のそれぞれに対する整合がなされ る。このように、2つの周波数の切換に応じて、それぞ 50 波数 f b に整合されるように設定されており、 f b 以外

れの周波数に整合させることで、高次高調波のレベルを 下げて、所望の出力電圧を得ることができる。

[0017]

【発明の実施の形態】本発明の第1の実施例にかかる電 圧制御発振器の構成を、図1を用いて説明する。なお、 図1において、図4と同一もしくは相当する部分には同 一の符号を付し、その説明は省略する。

【0018】図1において、1aは電圧制御発振器であ り、共振回路2、発振回路3、バッファ回路4、整合回 10 路5およびインピーダンス調整回路6aを備えてなる。 ここで、整合回路5を構成するインダクタは、互いに直 列に接続される2つのインダクク1.2、1.3からなる。 また、インピーダンス調整回路 6 a は、スイッチング素 子としてのダイオードD1、カップリングコンデンサC 8、およびバイアス抵抗R1を備える。このうち、カッ プリングコンデンサC8は、一端がインダクタL2、L 3の接続点に接続され、他端が直列にバイアス抵抗R1 に接続され、さらに、バイアス抵抗R1はスイッチング 電圧入力端子Vswに接続される。また、カップリング コンデンサC8とバイアス抵抗R1との接続点には、ダ イオードD1のアノード端子が接続され、ダイオードD 1のカソード端子は接地される。ここで、スイッチング 電圧入力端子Vswは、電圧制御発振器laが搭載され るセット側の制御手段に接続されており、この制御手段 からダイオードD1を駆動させるための電圧が印加され

【0019】次に、電圧制御発振器1aの動作を、80 0MHz帯に存在する周波数faと、1.6GHz帯に 存在する周波数 f b とを発振周波数とする場合を例に取 り、説明する。

【0020】まず、発振周波数がfaの場合、第1のト ランジスタTR1の出力信号は、カップリングコンデン サC4で増幅され、発振されて第2のトランジスタTR 2に入力される。このとき、スイッチング電圧入力端子 Vswから、ダイオードD1の駆動電圧は入力されな い。したがって、ダイオードD1は高周波的に開放状態 となり、カップリングコンデンサC8からダイオードD 1側は、インダクタL2、L3に対して電気的に切り離 される。ここで、整合回路5は、インダクタし2、し3 および整合用コンデンサC6による合成インピーダンス で、周波数faに整合されるように設定されており、f a以外の周波数は減衰され、出力端子Voutから、周 波数 faの信号のみが出力される。

【0021】一方、発振周波数が f b の場合、スイッチ ング電圧入力端子Vswから、ダイオードD1の駆動電 圧が入力される。これにより、ダイオードD1は高周波 的に接地されるため、インダクタL3は接地されること となる。ここで、整合回路5は、インダクタし3および 整合用コンデンサC6による合成インピーダンスで、周

の周波数は減衰され、出力端子Voutから、周波数fbの信号のみが出力される。

【0022】このように、電圧制御発振器1aにおいては、共振回路2で選択された周波数に応じて、ダイオードD1をオンオフさせることにより、インダクタL2、L3を選択的に使用する。これにより、整合回路5におけるインダクタンスが変化し、整合用コンデンサC6との合成インピーダンスが変化するため、2つの周波数のそれぞれに整合させることができるものである。したがって、高次高調波のレベルを下げて、所望の出力電圧を得ることができる。

【0023】次に、本発明の第2の実施例にかかる電圧制御発振器の構成を図2を用いて説明する。なお、図2において、図4と同一もしくは相当する部分には同一の符号を付し、その説明は省略する。

【0024】図2において、1 bは電圧制御発振器であり、共振回路2、発振回路3、バッファ回路4、整合回路5 およびインピーダンス調整回路6 b を備えてなる。ここで、インピーダンス調整回路6 b は、スイッチング素子としてのダイオードD1、およびバイアス抵抗R1を備える。このうち、ダイオードD1は、整合回路5を構成する整合用コンデンサC6の一端と接地との間に、整合用コンデンサC6に対して直列に接続される。また、整合用コンデンサC6の一端とダイオードD1との接続点は、バイアス抵抗R1を介してスイッチング端子Vswに接続される。

【0025】次に、電圧制御発振器1bの動作を説明する。

【0026】まず、電圧制御発振器1bの発振周波数が、800MHz帯の周波数faである場合には、ダイオードD1に駆動電圧が印加されることにより、ダイオードD1が高周波的に接地され、整合回路5は、整合用コンデンサC6のみの容量で接地されることとなる。ここで、整合回路5は、インダクタL1および整合用コンデンサC6による合成インピーグンスで、周波数faに整合されるように設定されており、周波数faの信号のみが出力される。

【0027】一方、発振周波数が1.6GHz帯のfbである場合、ダイオードD1に駆動電圧は印加されないため、ダイオードD1は高周波的には微小な容量をもつ40こととなる。ここで、ダイオードD1と整合用コンデンサC6とは直列に接続されているため、ダイオードD1と整合用コンデンサC6との合成容量においては、ダイオードD1の微小な容量が支配的となる。また、整合回路5は、インダクタL1およびダイオードD1による合成インピーダンスで、周波数fbに整合されるように設定されており、周波数fbの信号のみが出力される。

【0028】このように、電圧制御発振器1bにおいては、共振回路2で選択された周波数に応じて、ダイオードD1をオンオフさせることにより、整合回路5におけ

る容量を変化させ、インダクタL1との合成インピーダンスを変化させる。これにより、2つの周波数のそれぞれに整合させることができ、高次高調波のレベルを下げて、所望の出力電圧を得ることができる。

【0029】次に、本発明の第3の実施例にかかる電圧 制御発振器の構成を図3を用いて説明する。なお、図3 において、図1と同一もしくは相当する部分には同一の 符号を付し、その説明は省略する。

【0030】図3において、1cは電圧制御発振器であ り、共振回路 2、発振回路 3、バッファ回路 4、整合回 路5およびインピーダンス調整回路6cを備えてなる。 このうち、インピーダンス調整回路6cはスイッチング 素子としてのダイオードD1、カップリングコンデンサ C8、C9およびバイアス抵抗R1、R2を備える。こ こで、ダイオードD 1 は、整合回路 5 を構成する整合用 インダクタL1に対して並列に接続される。また、イン ダクタL1の一端と、ダイオードD1のアノード端子と の間に、カップリングコンデンサC8が接続され、ダイ オードD1のカソード端子と、インダクタL1の他端と の間に、カップリングコンデンサ С 9 が接続される。ま た、カップリングコンデンサC8の一端とダイオードD 1との接続点は、バイアス抵抗 R 1を介してスイッチ端 子Vswに接続され、ダイオードD1のカソード端子 は、バイアス抵抗R2を介して接地される。

【0031】次に、電圧制御発振器1cの動作を説明する。

【0032】まず、電圧制御発振器1cの発振周波数が800MHz帯のfaである場合、ダイオードD1の駆動電圧が印加され、ダイオードD1は高周波的に短絡される。このため、整合回路5のインダクタL1は、カップリングコンデンサC8と並列に接続されることとなる。この際、インダクタL1、ならびに、カップリングコンデンサC8および整合用コンデンサC6による合成インピーダンスは、ダイオードD1に駆動電圧を印加しない場合の合成インピーグンスより大きな値となる。ここで、整合回路5は、イングクタL1および整合用コンデンサC6による合成インピーダンスで、周波数faに整合されるように設定されており、周波数faに整合されるように設定されており、周波数faに

【0033】一方、電圧制御発振器1cの発振周波数が、1.6GHz帯の周波数fbである場合には、ダイオードD1に駆動電圧は印加されない。したがって、ダイオードD1は、高周波的には微小な容量を持つこととなり、ダイオードD1と、ダイオードD1に直列に接続されたコンデンサC8との合成容量は、ダイオードD1の容量が支配的となり、微小な値となる。このように、コンデンサC8およびダイオードD1の合成容量が微小であるため、コンデンサC8およびダイオードD1に並列に接続されたインダクタL1のインダクタンスは、ほとんど変化しない。ここで、整合回路5は、インダクタ

L1および整合用コンデンサC6による合成インピーダンスで、周波数 fbに整合されるように設定されており、周波数 fbの信号のみが出力される。

【0034】このように、電圧制御発振器1cにおいては、共振回路2で選択された周波数に応じて、ダイオードD1をオンオフさせることにより、インダクタL1のインダクタンスを変化させ、整合用コンデンサC6との合成インピーダンスを変化させる。これにより、2つの周波数のそれぞれに整合させることができ、高次高調波のレベルを下げて、所望の出力電圧を得ることができる

【0035】なお、上記第1乃至第3の実施例においては、スイッチング索子として、ダイオードを用いる場合について説明したが、トランジスタ、もしくはバリキャップダイオードを用いてもよい。

【0036】また、上記第1乃至第3の実施例において、ダイオードに印加する駆動電圧は、共振回路を駆動させる電圧と共用としてもよい。

[0037]

【発明の効果】本発明にかかる電圧制御発振器によれば、共振回路で選択された周波数に応じて、インピーダンス調整回路を構成するスイッチング素子がオンオフされる。これにより、整合回路におけるインダクタンスまたは容量が変化し、その結果、合成インピーダンスが変

化し、2つの周波数のそれぞれに整合される。このように、2つの周波数の切換に応じて、それぞれの周波数に整合させることで、高次高調波のレベルを下げて、所望の出力電圧を得ることができる。

8

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例にかかる電圧制御発振器 を示す回路図である。

【図2】本発明の第2の実施例にかかる電圧制御発振器 を示す回路図である。

10 【図3】本発明の第3の実施例にかかる電圧制御発振器 を示す回路図である。

【図4】従来の電圧制御発振器を示す回路図である。 【符号の説明】

la、lb、lc 電圧制御発振器

2 共振回路

3 発振装置

4 バッファ回路

5 整合回路

6a、6b、6c インピーダンス調整回路

20 C6 整合用コンデンサ

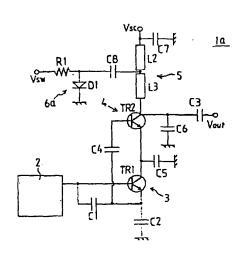
D1 スイッチング素子 (ダイオード)

L1、L2、L3 インダクタ

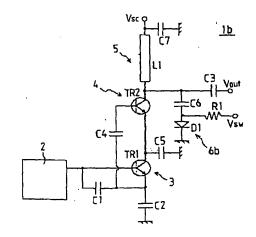
TR1 第1のトランジスタ

TR2 第2のトランジスタ

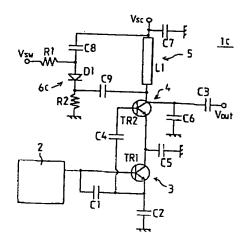
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

